

■ 用途 Application

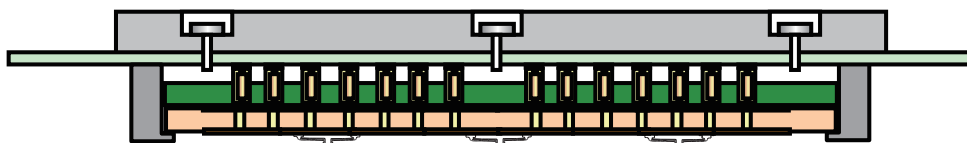
MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)技術と多層薄膜配線技術で構成されたMEMS型プローブカードです。12インチサイズのウェハー一括コンタクトに対応しています。MCシリーズはDRAMやNAND型フラッシュメモリデバイスに最適なプローブカードです

■ 特長 Feature

1. 全パッドに均一な低スクラブで安定した接触性
2. テストタイム短縮によるコスト削減
3. 高耐電流特性と高耐摩擦性能
4. 広範囲(低温から高温)の温度測定合金針の採用による安定接触性

基本仕様 Specifications

パッドピッチ Pad Pitch	60 μ m(50 μ m開発中)	最大OD Max OD	100 μ m
パッドサイズ Pad size	45 μ m \times 55 μ m	基板下面~針先 Probe Depth	12.0mm \pm 0.3mm
針立て領域 Max Probe Area	ϕ 300mm	最大電流 Max Current	1200mA
針位置精度 Alignment	\pm 6 μ m	使用温度 Temperature range	-40 $^{\circ}$ C~100 $^{\circ}$ C
高さバラツキ Planarity	30 μ m	最大ピン数 Max Pin	100,000
推奨OD時の針圧 Probe force	2.5gf@OD=80 μ m		



※MC断面図

Your Probing Partner



JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION
日本電子材料株式会社

<http://www.jem-net.co.jp/>